

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) Nº de publication : 3 001 097
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)
(21) Nº d'enregistrement national : 14 50111
(51) Int Cl⁸ : H 03 K 17/12 (2013.01)

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 08.01.14.
(30) Priorité : 15.01.13 US 13742086.

(43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 18.07.14 Bulletin 14/29.
(56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Ce dernier n'a pas été établi à la date de publication de la demande.
(60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(71) Demandeur(s) : TRIQUINT SEMICONDUCTOR, INC.
— US.

(72) Inventeur(s) : PRABHAKAR RAVISHANKAR et
FURINO JR. JAMES P..

(73) Titulaire(s) : TRIQUINT SEMICONDUCTOR, INC..

(74) Mandataire(s) : CABINET PLASSERAUD.

(54) DISPOSITIF DE COMMUTATION AVEC DIVISEUR RESISTIF.

(57) Des modes de réalisation proposent un dispositif de commutation comprenant

un ou plusieurs transistors à effet de champ (FET) (104). Dans des modes de réalisation, un diviseur résistif (132) comprenant une première résistance (136) et une seconde résistance (140) peut être couplé au FET à une position électriquement entre une borne de grille (120) du FET et une borne de corps (124) du FET.

